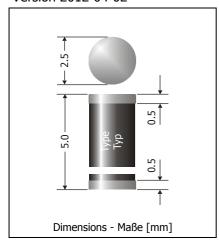


## SM4001 ... SM4007, SM513, SM516, SM518, SM2000

## Surface Mount Silicon Rectifier Diodes Silizium-Gleichrichterdioden für die Oberflächenmontage

## Version 2012-04-02

**Maximum ratings** 



Nominal current 1 A
Nennstrom

Repetitive peak reverse voltage 50...2000 V
Periodische Spitzensperrspannung

Plastic case MELF DO-213AB
Kunststoffgehäuse MELF

Weight approx. – Gewicht ca. 0.12 g

Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert

Standard packaging taped and reeled Standard Lieferform gegurtet auf Rolle



Grenzwerte

Type Typ	Repetitive peak reverse v Periodische Spitzensperrsp V <sub>RRM</sub> [V]		Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V <sub>RSM</sub> [V]		
SM4001	50		50		
SM4002	100			100	
SM4003	200		200		
SM4004	400		400		
SM4005	600		600		
SM4006	800		800		
SM4007	1000		1000		
SM513	1300		1300		
SM516	1600		1600		
SM518	1800			1800	
SM2000	2000		2000		
Max. average forward rectified current, R-load Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last		$T_{T} = 75^{\circ}C$ $T_{T} = 100^{\circ}C$	$\mathbf{I}_{FAV}$	1 A 0.8 A	
Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom		f > 15 Hz	${ m I}_{\sf FRM}$	10 A ¹)	
Peak forward pulse cur Max. zulässiger Stromi	·	$T_A = 85$ °C	${ m I}_{\sf FSM}$	100 A	

Mounted on P.C. board with 25 mm<sup>2</sup> copper pads at each terminal Montage auf Leiterplatte mit 25 mm<sup>2</sup> Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss

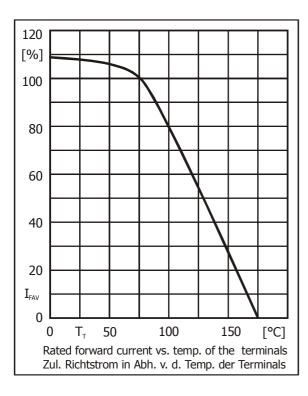


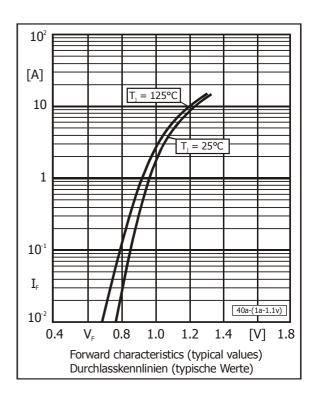
Maximum ratings Grenzwerte

Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwelle	$T_A = 25^{\circ}C$	$I_{FSM}$	40/44 A ¹)
Rating for fusing, t < 10 ms Grenzlastintegral, t < 10 ms	$T_A = 25^{\circ}C$	i²t	8 A <sup>2</sup> s
Junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur			-50+175°C -50+175°C

**Characteristics**Kennwerte

Forward voltage Durchlass-Spannung	$T_j = 25$ °C	$I_F = 1 A$	V <sub>F</sub>	< 1.1 V
Leakage current Sperrstrom	$T_{j} = 25$ °C $T_{j} = 100$ °C	$V_R = V_{RRM}$ $V_R = V_{RRM}$	$\begin{matrix} I_{R} \\ I_{R} \end{matrix}$	< 5 μA < 50 μA
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft			R <sub>thA</sub>	< 45 K/W <sup>1</sup> )
Thermal resistance junction to terminal Wärmewiderstand Sperrschicht – Anschluss			R <sub>thT</sub>	< 10 K/W





2 http://www.diotec.com/ © Diotec Semiconductor AG

Mounted on P.C. board with 25 mm² copper pads at each terminal Montage auf Leiterplatte mit 25 mm² Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss